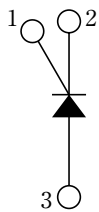


THYRISTOR

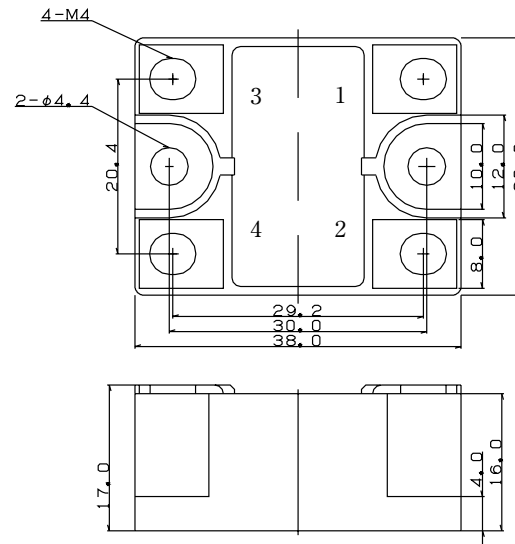
30A Avg 800 Volts

PHT308C

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)



■最大定格 Maximum Ratings

項 目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade	単位 Unit
		PHT308C	
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DRM}	800	V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DSM}	900	V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	800	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	900	V

項 目 Parameter		記号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
平均整流電流 Average Rectified Output Current		I ₀ (AV)	商用周波数 180° 通電 T _c = (TBD) °C Half Sine Wave		30	A
実効オン電流 RMS On-State Current		I _T (RMS)			47	A
サージオン電流 Surge On-State Current		I _{TSM}	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive		500	A
電流二乗時間積 I Squared t		I ² t	2 ~ 10ms		1250	A ² s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current		di/dt	V _D =2/3V _{DRM} , I _{TM} =2・I _O , T _j =125°C I _G =200mA, dig/dt=0.2A/μs		100	A/μs
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power		P _{GM}			5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power		P _G (AV)			1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current		I _{GM}			2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage		V _{GM}			10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage		V _{RGM}			5	V
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		T _{jw}			- 40 ~ + 125	°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T _{stg}			- 40 ~ + 125	°C
絶縁耐圧 Isolation Voltage		V _{iso}	端子 - ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1 min.		2500	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M4	1.5 (1.4)	N・m
	主端子部 Terminal			M4	1.5 (1.4)	N・m

■電気的特性 Electrical Characteristics

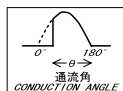
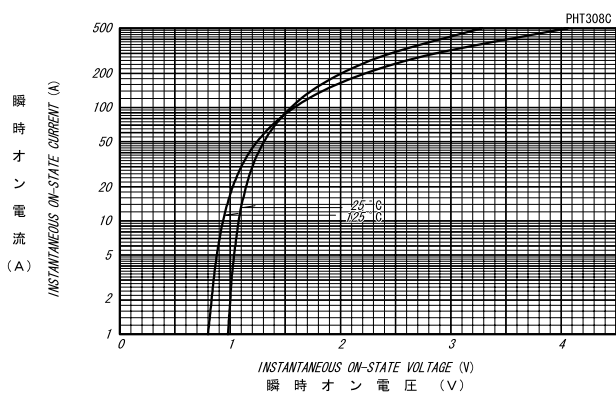
項 目 Parameter	記号 Symbol	条 件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I _{DM}	T _j =125℃, V _{DM} =V _{DRM}			10	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I _{RM}	T _j =125℃, V _{RM} =V _{RRM}			10	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V _{TM}	T _j =25℃, I _{TM} =90A			1.50	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I _{GT}	V _D =6V, I _T =1A			T _j = - 40℃ 200	mA
					T _j = 25℃ 100	mA
					T _j = 125℃ 50	mA
					T _j = - 40℃ 4	V
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V _{GT}	V _D =6V, I _T =1A			T _j = 25℃ 2.5	V
					T _j = 125℃ 2	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V _{GD}	T _j =125℃, V _D =2/3V _{DRM}	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	T _j =125℃, V _D =2/3V _{DRM}	500			V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t _q	T _j =125℃, I _{TM} =I _O , V _D =2/3V _{DRM} dv/dt=20V/μs, V _R =100V, - di/dt=20A/μs		100		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t _{gt}	T _j =25℃, V _D =2/3V _{DRM} I _G =200mA, di _G /dt=0.2A/μs		6		μs
遅れ時間 Delay Time	t _d			2		μs
立上がり時間 Rise Time	t _r			4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I _L	T _j =25℃		100		mA
保持電流 Holding Current	I _H	T _j =25℃		50		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部－ケース間 Junction to Case,			0.9	℃/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(c-f)}	ケース－フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased			0.3	℃/W

質量…約35g

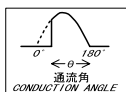
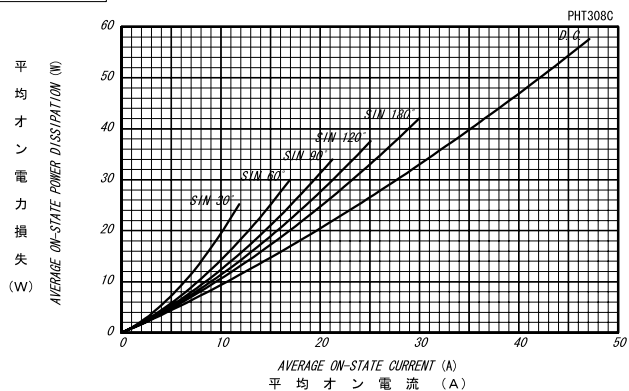
Approximate Weight

■ 定格・特性曲線

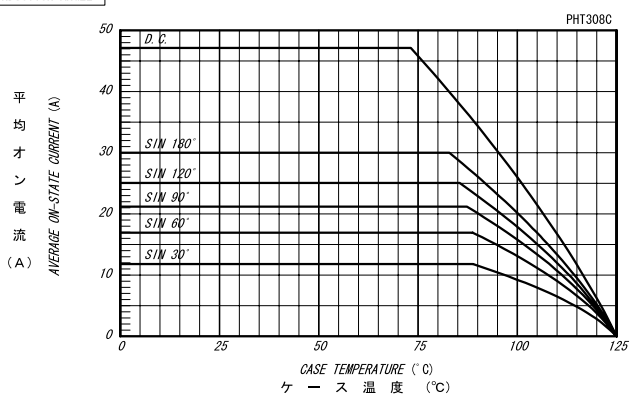
オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE



平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

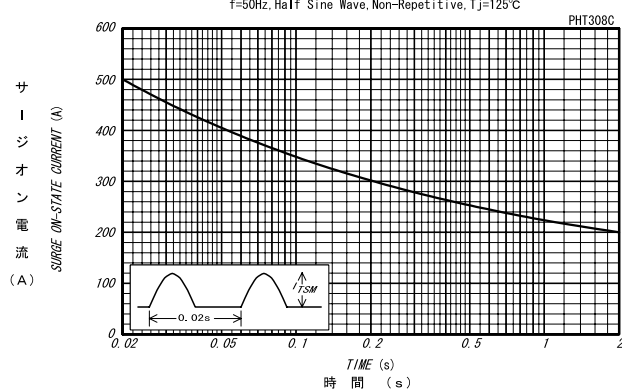


平均オン電流－ケース温度定格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



サージオン電流定格
SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, T_j=125°C



過渡熱抵抗特性
MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
Junction to Case

